

先端機器共用施設ネットワーク「イノベーションつくば」ワークショップ
～テーマ「つくばを元気にするネットワークと人材育成」～

先端研究施設共用促進事業

「マルチタンデム加速器施設の学術・産業共用促進事業」

- 高度制御加速イオンビーム産業利用によるイノベーション創出と人材育成 -



筑波大学
University of Tsukuba

筑波大学研究基盤総合センター応用加速器部門

<http://web2.tac.tsukuba.ac.jp/innovation/>

innovation@tac.tsukuba.ac.jp

筑波大学研究基盤総合センター応用加速器部門では、高度に制御されたイオンビーム・放射線を用いた物質や環境分野に関する先端計測・分析技術の研究開発を推進している。これまでの基礎研究の成果と蓄積された先端計測・分析技術をさらに発展させ、文部科学省補助事業「先端研究施設共用促進事業」(事業課題名:マルチタンデム加速器施設の学術・産業共用促進事業)による産学連携研究を進展させている。また産業界との連携により、つくば研究学園地区に存在する多くの先端的研究施設と相互協力関係を構築し、新たな研究教育拠点を形成することを目指している。

筑波大学マルチタンデム加速器施設

筑波大学では、先端的量子ビームを提供可能なマルチタンデム加速器システム(12MVタンデム加速器(図1, 2)および1MVタンデトロン加速器(図3))と放射線応用実験装置(図4)が産学連携研究に利用可能である。



図1 筑波大学マルチタンデム加速器施設

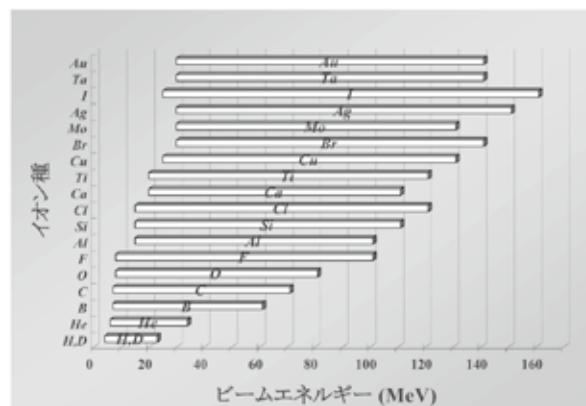


図2 高度制御イオンビームのエネルギー範囲
(12 MV タンデム加速器)



図3 物質分析用1MVタンデトロン加速器

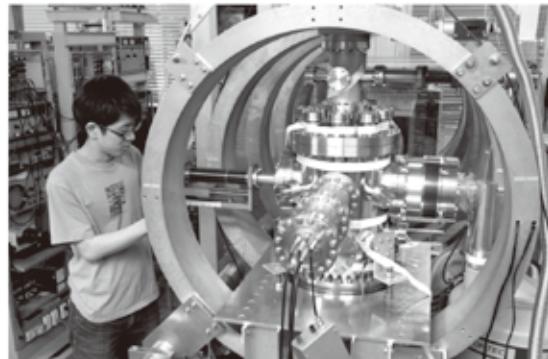


図4 低速陽電子ビーム解析装置

先端機器共用施設ネットワーク「イノベーションつくば」ワークショップ ～テーマ「つくばを元気にするネットワークと人材育成」～

産学連携事業(平成19年度～)の利用実績

筑波大学マルチタンデム加速器システムと放射線応用実験装置(陽電子消滅測定およびメスバウアーフィルタ光測定)による、産学連携研究開発の利用実績を表1に示す。

事業応募課題は、課題選定評価委員会で審議し、採択後は

- ・静電加速器および実験・データ処理に係る施設使用料は不要
 - ・施設共用実験支援研究員ら部門関係職員の全面的な支援のもとでの研究開発活動
 - ・施設利用成果報告書は原則公開であるが特許取得等の理由により2年間は非公開にできる等が措置される。

表1 筑波大学マルチタンデム加速器施設における産学連携研究課題実績(平成19-21年度)

産学連携イノベーションによる人材育成

科学技術の高度化・複雑化に伴い、最先端の技術や知識を組合せることにより新たな価値を生み出す「オープンイノベーション」の重要性が高まっている。産業構造の急激な変化による人材ニーズの多様化・高度化に応えるため、大学等の研究教育機関では高いレベルの知識と専門性を備え、生産性向上やイノベーション創出に寄与しうる人材の育成が急務の課題となっている。筑波大学マルチタンデム加速器施設での产学連携事業の推進は、科学技術立国の将来を担う若手研究者・学生の教育・研究の活性化に資することが期待されている。

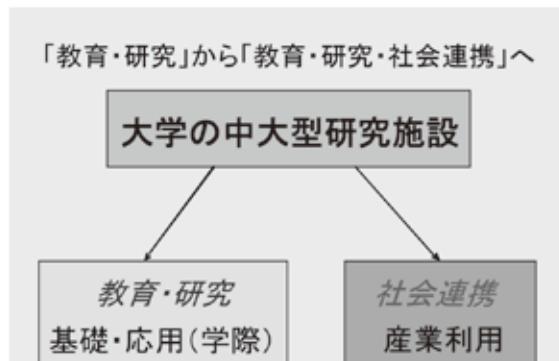


図5 大学の研究教育施設における教育・研究と社会連携

先端機器共用施設ネットワーク「イノベーションつくば」ワークショップ ～テーマ「つくばを元気にするネットワークと人材育成」～

超微細加工・計測・分析支援とその技術者養成によるイノベーション創出 ナノプロセシング・パートナーシップ・プラットフォーム

進歩の速いナノテクノロジー・ナノエレクトロニクスにおいては、如何にスピーディに、新材料・デバイスのプロトタイプを作製し、その結果を次のステップの研究開発に結びつけられるかが、研究開発の成否を分けると言っても過言ではありません。

産総研ナノプロセシング・パートナーシップ・プラットフォームは、産総研内外の研究機関と協力して、ナノテクノロジー・ナノエレクトロニクスにかかる研究支援と人材育成事業を進めるオープンイノベーションプラットフォームです。

装置利用の支援例 —微量イオン物質のセンシング技術研究と環境センサの開発—

F 産総 H20-017

研究目的

大気汚染、水質汚染、廃棄物による土壤汚染など環境問題が深刻化する昨今、環境改善、特に寄与する技術は重要であり、特に、微量元素成分の簡易・迅速分析のニーズは非常に高い。本研究開発では、自己組織化膜のセンシング機能に着目し、その有機基板上への展開を進めている。自己組織化膜のセンシングは、電極表面に自己組織化膜を修飾し、イオンの吸着前後での表面電位差を測定するものである。一方、これらの実用化には、従来にない多電極構造が不可欠であり、そのための基板としては、有機基板が有望と考えている。平成 20 年度は主に、安定したセンシング機能を実現するための金(Au)/銅(Cu)電極構造を検討し、その適正化の見通しを得た。

成 果

全電極断面の加工と評価として、集束イオンビーム加工装置(FIB)による加工、走査電子顕微鏡(SEM)による断面観察、エネルギー分散型蛍光 X 線分析装置(EDX)による元素分析を行った(図1)。その結果、安定したセンシングが得られない素子では、Au 層と下地として採用した Cu 層間に相互扩散が生じ、常温でもその扩散が継続する傾向が見られた。これは、2種金属間の局部電場効果に起因すると考えられる。そこで、拡散防止膜として、導電カーボンペーストの電極界面(Cu/Au 界面)への導入を検討した。具体的には、UV クリーナー、プラズマアッシャーによる界面改質、真空蒸着装置によるカーボン層上への Au 層の形成を実施した。その結果、良好なセンシング機能とその再現性を確認することに成功した(図2)。

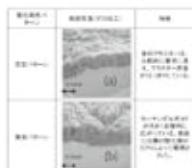


図1：安定・貯蔵センシングが実現された電極の断面写真およびその構造。

立化成工業株式会社：中村英博 様

大気汚染、水質汚染、廃棄物による土壤汚染など環境問題が深刻化する昨今、環境改善、特に寄与する技術は重要であり、特に、微量元素成分の簡易・迅速分析のニーズは非常に高い。本研究開発では、自己組織化膜のセンシング機能に着目し、その有機基板上への展開を進めている。自己組織化膜のセンシングは、電極表面に自己組織化膜を修飾し、イオンの吸着前後での表面電位差を測定するものである。一方、これらの実用化には、従来にない多電極構造が不可欠であり、そのための基板としては、有機基板が有望と考えている。平成 20 年度は主に、安定したセンシング機能を実現するための金(Au)/銅(Cu)電極構造を検討し、その適正化の見通しを得た。

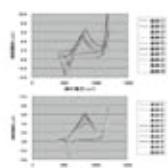


図2：電極界面の表面改質／後(上段)／下段(下段)のセンシング特性、基底層により前処理したシングル層が得られている。

装置利用の支援例 —プラズマ合成した ZnO 透明導電膜の不純物検査—

F 産総 H20-059

研究目的

複数性材料の合成に必要な資源の枯渇が深刻化している昨今、無毒で国内クラーク数の大きい元素資源を活用することによる、既製材料を代替し得る新材料の開発が求められている。本研究では、透明導電膜(TCF)の主たる材料である ITO(In-Sn-O)や、太陽電池に用いられる CIS(Cu-In-Se)を構成する希少金属インジウム(In)の枯渇問題に対応すべく、これら機能性材料を代替するノンドープ酸化亜鉛(ZnO)透明導電膜(*注)のプラズマ低温合成に取り組んでいる。合成は、低気圧の純触素(O₂)誘導結合プラズマ中に、不純物無添加の亜鉛(Zn)蒸気を導入する手法を用い、バイレックスガラス基板上に非基板加熱で行っている。この手法を用いることにより、可視透過度 85 % 以上で、かつ低熱抵抗率(10⁻¹Ω·cm 前半)の透明導電膜が再現性良く得られている。H20 年度 NPP 支援においては、当該透明導電膜を構成する元素の膜厚深さ方向プロファイルを、エックス線光電子分光(XPS)法により厳密に評価することにより、当該透明導電膜に水素以外の不純元素の混入がないことを確認した。このことは、準ノンドープ ZnO 透明導電膜の合成の成功を裏付けている。

(*注) 不純物(ドーピント)の濃度により結晶格子内に電子が移出される場合、その電子の強度(即ちイオン化不純物)は結晶内の穴隙として残る。つまり、イオン化不純物はキャリアの散乱源となり、電子移動度を下げるに及ぶ。また、すべての不純物が電子を困らせるわけではなく、格子間隙に嵌入したり結晶格子や表面に偏析する場合もある。結晶化で着色したシリコン抵抗が変わらなど、材料科学としての寿命に問題を残してしまうため、不純物を添加しない準ノンドープ ZnO 透明導電膜の発展が望まれている。

成 果

図1に、原子濃度の Ar スパッタリング時間依存性を示す。スパッタリング時間がゼロの場合は、導体表面の原子種濃度となる。スパッタリングが進行しても約 100 分までは、O, Zn 原子以外の不純物(Si, Al, N, C)濃度は 1.5 % 以下となっている。C については、スパッタリング時間 100 分を超えたガラス中でも 1.6 % 観測されていることから、C の横出限界がその程度であり、また、最表面の 4.3 と 2.7 % の炭素量は有機物の汚れに起因すると考えられる。また、スパッタリングが基板に到達するまで、O と Zn の存在量はほぼ一定であり、それらの合計は、ほぼ 100 % の存在量を示している。合成功能の質量分析からも O, O₂, Zn 以外のスペクトラムは検出に観測されていない。以上の結果は、抵抗率の低い準ノンドープ ZnO 透明導電膜の合成の成功を裏付けている。

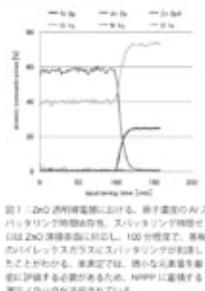


図1：ZnO 透明導電膜における、原子濃度の Ar スパッタリング時間依存性。スパッタリング時間が ZnO 透明導電膜表面に到達し、100 分程度で、導体のバイレックスガラスにスパッタリングが到達したことわかる。測定では、既存の元素量を基に測定する必要があるため、NPP に基づく測定ノハラが用いられている。

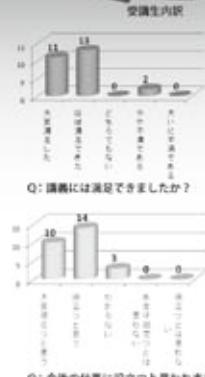
ナノテク製造中核人材の養成プログラム

平成21年度実施カリキュラム～ナノエレクトロニクス(テクノ・プロセス専門研修)～

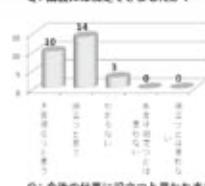


受講生内訳

講義名	講義内容	担当者	担当者名
ナノプロセスの基礎知識	基礎知識	大澤 大	大澤 大
ナノプロセス実習	実習	田中 雄一	田中 雄一
TCF 制作	導電性薄膜の作成	大澤 大	大澤 大
表面分析技術実習	表面分析	吉川 順一	吉川 順一
ナノ材料実習	ナノ材料	吉川 順一	吉川 順一
Nano Lab	Nano Lab	吉川 順一	吉川 順一
表面改質実習	表面改質	吉川 順一	吉川 順一
表面改質実験	表面改質	吉川 順一	吉川 順一
ナノ構造表面の表面改質	表面改質	吉川 順一	吉川 順一
Emerging Research Devices	新規デバイス	平井 伸也	平井 伸也
Emerging Research Materials	新規材料	平井 伸也	平井 伸也



Q: 講義には満足できましたか？



Q: 今后の仕事に役立つと思われますか？

中核人材育成事業では、製造現場で必要とされる知識や技能をもつ人材を継続的に育成してゆくことを目的に、カリキュラムが設定されております。

お問い合わせ先

独立行政法人 産業技術総合研究所
ナノプロセシング・パートナーシップ・プラットフォーム

〒305-8568
茨城県つくば市梅園1-1-1中央第2
TEL 029-861-3210
FAX 029-861-3211
E-Mail npp-info(@)m.aist.go.jp



超微細加工・計測・分析支援とその技術者養成によるイノベーション創出
ナノプロセシング・パートナーシップ・プラットフォーム

<http://www.nanoworld.jp/npp/>



先端機器共用イノベーションプラットフォーム
<http://www.open-innovation.jp/ibec/>



先端機器共用施設ネットワーク「イノベーションつくば」ワークショップ ～テーマ「つくばを元氣にするネットワークと人材育成」～

平成21年度第1回 NPPPスクール

ナノサーチ顕微鏡セミナー～走査型レーザ顕微鏡/走査型プローブ顕微鏡複合装置の技術と応用～

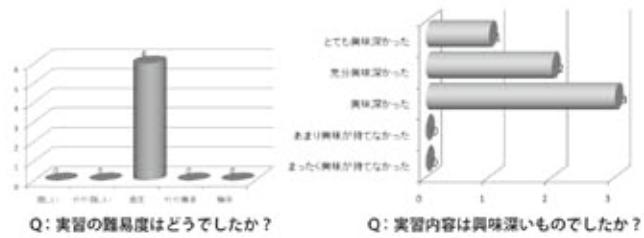
本セミナーは、株式会社島津製作所殿の全面的なご協力のもとに開催されました。ナノサーチ顕微鏡/SFT-3500は、大型試料対応の超高倍率三次元測定顕微鏡です。光学顕微鏡・レーザ顕微鏡の多彩な観察法を駆使して観察位置をスピーディーに特定し、試料を移動させずにそのまま走査型プローブ顕微鏡(SPM)観察ができます。ミリメートル領域からナノメートル領域までの計測が一台で実行できる、スコープバリアフリーを実現した画期的な装置です(島津製作所ウェブページより)。

[講義] 平成21年6月15日(月) 産総研

題 目	講 師
ナノサーチ顕微鏡の要発とアプリケーション	㈱島津製作所 棚田良平 氏

[実習] 平成21年6月16日(火)～19日(金) 産総研

実験操作トレーニング	監督・指導：㈱島津製作所分析計測事業部 棚井晶造 氏
試料測定・分析	監督・指導：㈱島津製作所分析計測事業部 棚井晶造 氏 島津総合分析試験センター 小畠亮輔 氏



平成21年度人材育成スクール

超微細加工・ナノ計測・分析人材育成スクール

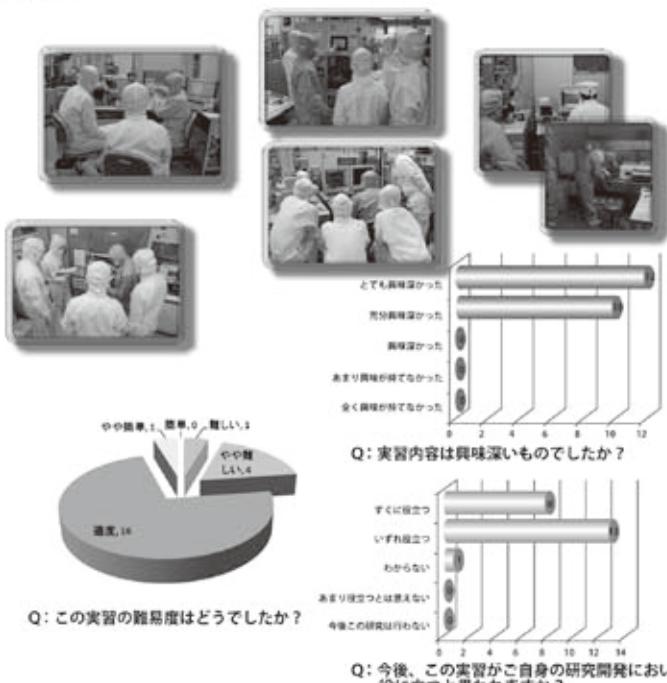
本スクールは、文部科学省ナノテクノロジー・ネットワーク事業の一環として、産学官の研究者に、超微細加工・ナノ計測・分析に関する装置やその原理を学習する場と、それらの技術を実地に習得する機会を提供し、ナノテクノロジーにおける人材育成に貢献することを目的としています。本年度のスクールでは、講義6コマをつくばで開催し、実習5科目を産業技術総合研究所、物質・材料研究機構、東京工業大学の3カ所で実施しました。

[実習] 平成21年10月8日(木)～11月13日(金)

走査型イオンビーム加工技術(FIB) & 透過型電子顕微鏡(TEM)	 走査型イオンビーム加工技術(FIB) ・断面加工及び観察に関する実習 ・任意パターン露光による加工に関する実習 ・FIB加工による微小試料の抽出と薄膜加工に関する実習
物性研(TEM)	 物性研(TEM) ・構造と基本操作、転写装置の基本、明視野・暗視野観察、回折パターンの取得、高分辨率観察 ・場合により、EDS、EDSの基礎(物性・材料研究機構)
電子ビーム描画(EB描画)	 電子ビーム描画(EB描画) ・CADパターン設計の実習 ・ペクタ走査による描画力実習
東工大	 東工大 ・三層レジスト形成実習 ・重ねEB描画実習
X線回折(XRD) [基礎コース]	 X線回折(XRD) [基礎コース] 走査型電子顕微鏡(SEM/EDX) [基礎コース]
走査型電子顕微鏡(SEM/EDX) [基礎コース]	 走査型電子顕微鏡(SEM/EDX) [基礎コース] ・X線回折測定の実習 ・X線による反射率測定と解析方法の実習
プラズマ技術 [基礎コース]	 プラズマ技術 [基礎コース] 走査型電子顕微鏡(SEM/EDX) [基礎コース]
走査型電子顕微鏡(SEM/EDX) [基礎コース]	 走査型電子顕微鏡(SEM/EDX) [基礎コース] 基本的な像観察方法に関する実習 ・照射方法による像の違いに関する実習 ・エネルギー分散X線分析に関する実習

[講義] 平成21年10月5日(月) 産総研

講 義 名	講 師
走査型プローブ顕微鏡観察技術(SPM)	㈱島津製作所 棚田良平 氏
微細加工のためのプラズマ技術	東北大 子川誠二 氏
集束イオンビーム加工観察技術(FIB)	㈱日立ハイテクノロジーズ 石谷 亨 氏
透過型電子顕微鏡(TEM)	(独)物質・材料研究機構 三石 和貴 氏
X線回折(XRD)	㈱リガク 八坂 美穂 氏
電子線描画技術(EB描画)	東京工業大学 宮本 敏幸 氏



先端機器共用施設ネットワーク「イノベーションつくば」ワークショップ
～テーマ「つくばを元気にするネットワークと人材育成」～

文部科学省イノベーション創出事業ナノテクノロジー・ネットワークプロジェクト

NIMS国際ナノテクノロジーネットワーク拠点

世界最高水準の電子顕微鏡やNMRマグネット、超微細加工装置群などの最先端施設・設備を、
企業や大学などの利用希望者に開放し、共同利用・機器利用などの機会を広く提供

▶ 「創る」「観る」「測る」の総合的かつ、迅速性のある
支援によるイノベーションの創出

Innovation by integrated and speedy nanotechnology support consisting of "Fabrication", "Observation" and "Measurement".

▶ 無機、有機、金属、半導体、生体を含めた融合的な開発
支援による先端融合技術の創出

Creation of advanced interdisciplinary nanotechnology through integrated research and development of inorganic and organic materials, metals, semiconductor materials and biomaterials.

▶ 先端融合分野における人材の育成

Fostering of scientists in the field of advanced interdisciplinary nanotechnology

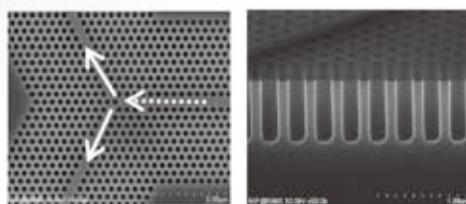


NIMSナノテクノロジー拠点 体制図
Organization of NIMS International Center for Nanotechnology Network



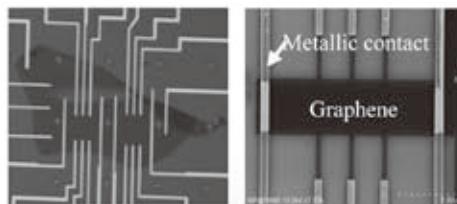
フォトニック結晶光導波路素子、グラフェン素子の開発

Development of photonic crystal waveguide and graphene devices



直径200nm、深さ500nmの周期的穴構造から成るフォトニック結晶光導波路の開発

Development of a photonic crystal waveguide device which consists of periodic air-holes structure with a lattice constant and hole diameter are 300 nm, and 200 nm, respectively. The depth of air-holes is 500 nm.



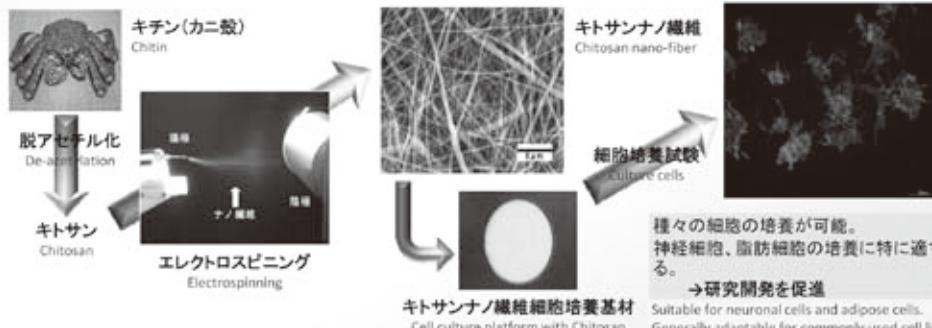
グラフェンシートにEB描画装置および真空蒸着装置を用いて、高精度に位置合わせした金属電極形成したナノスケール・グラフェン素子の開発

Development of a graphene device which consists of precise controlled formation of electrodes on the surface by using an EB lithography and a metal evaporation system.

ナノ繊維細胞培養基材の開発*

Development of cell culture platform with nano-scale fibers

キトサンナノ繊維を利用した細胞培養基材の性能を評価した。培養基材は2008年10月より試験販売されている。We have developed cell culture platform with chitosan-nano-scale fibers which will be on the market starting this October.

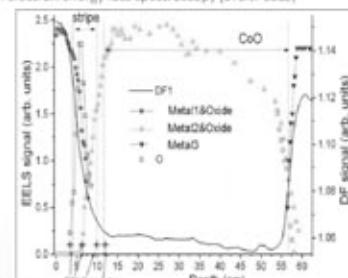
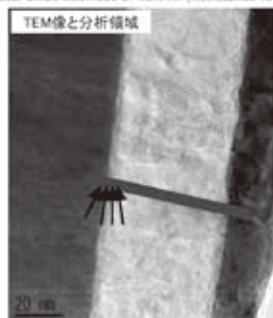


走査透過型電子顕微鏡(STEM)による界面構造の原子レベル解析*

*(独)産業技術総合研究所
との共同研究

Atomic level analysis of interface structures with scanning transmission electron microscopy (STEM)
ReRAM(Resistance-RAM)用の金属-金属酸化膜多層構造のエネルギー損失分光法(STEM-EELS)による分析

Metal and metal-oxide interface of ReRAM (Resistance-RAM) observed by STEM with electron energy loss spectroscopy (STEM-EELS)



電子エネルギー損失分光法による断面の組成比
Compositional changes across the metal and metal-oxide interface with EELS

先端機器共用施設ネットワーク「イノベーションつくば」ワークショップ
～テーマ「つくばを元気にするネットワークと人材育成」～

『光の工場』フォトンファクトリー

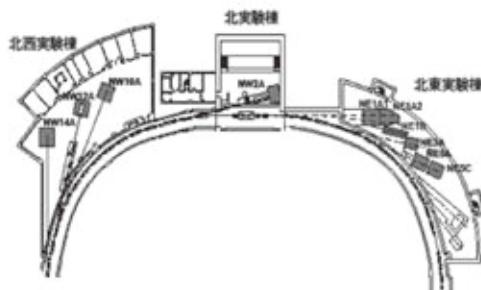
●フォトンファクトリーの概要 (<http://pfwww.kek.jp/indexj.html>)

フォトンファクトリー(Photon Factory)は、我国初の大型放射光共同利用施設として1982年に稼働開始しました。以来、産学官の多様なニーズに応え、放射光技術開発のパイオニアの役割を果たしてきました。

蓄積電子エネルギー2.5GeVの蓄積リングPFと、同6.5GeVのPF-ARの二つの放射光源により、紫外光から100keV程度の硬X線までの広いエネルギー領域の放射光が利用可能です。

●PF-AR(Advanced Ring)

PF-ARは、高エネルギー実験のためのブースター加速器を放射光源に転用したものですが、世界でも類を見ない単バシチ運転専用の大強度パルス放射光源として、時間分解実験の強力なツールとなっています。

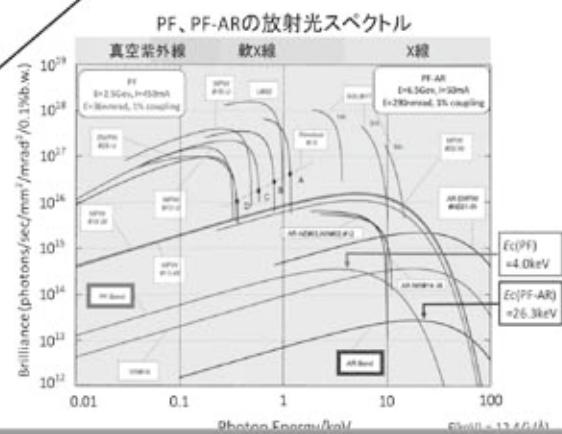
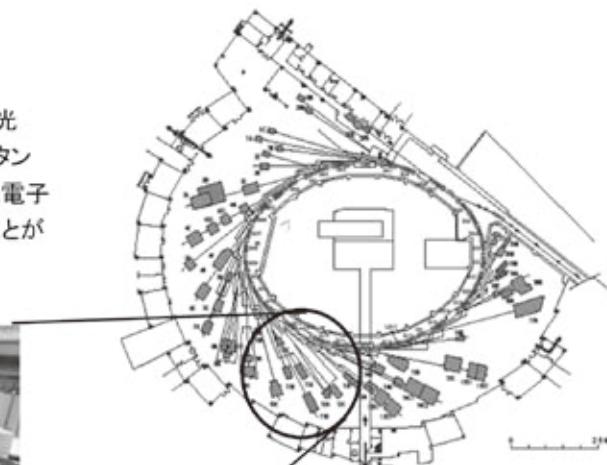


●実験ステーション

50以上の実験ステーションで、蛍光X線分析、X線吸収分光(XAFS)、イメージング、単結晶構造解析、粉末X線回折、タンパク質構造解析、高圧下でのX線回折、X線小角散乱、光電子分光、光電子顕微鏡等、バラエティに富んだ実験を行うことが可能です。



PF実験ホールの俯瞰写真。



●進化するフォトンファクトリー

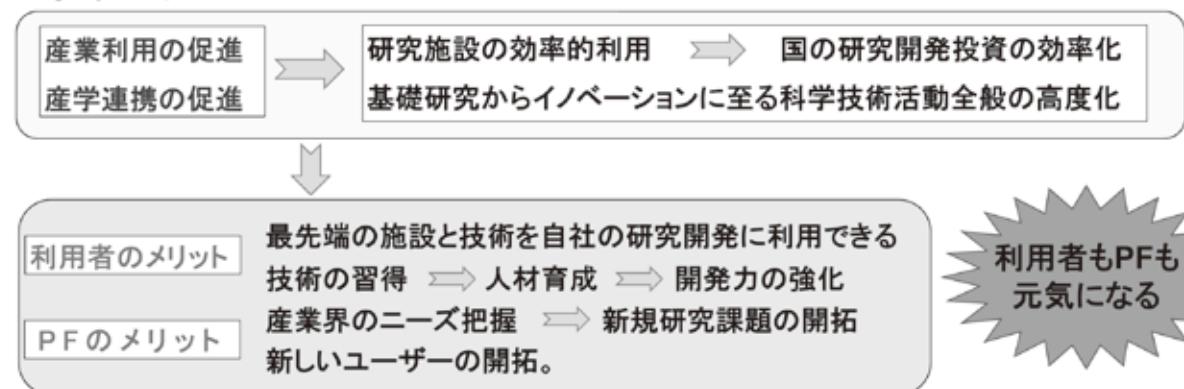
PFは運転開始以来、2度の高輝度化改造、および插入光源のための直線部増強改造を行い、第三世代光源に近い高性能光源に進化しています。

先端機器共用施設ネットワーク「イノベーションつくば」ワークショップ
～テーマ「つくばを元気にするネットワークと人材育成」～



文科省補助事業「先端研究施設共用促進事業」 「フォトンファクトリーの産業利用」

●事業のねらい



●利用の方法

- ◆利用者: 単独または複数の企業、業界コンソーシアム、地域公設試等。大学、独法等との共同も可
- ◆トライアルユース: 無償
 - 利用者や適用対象が新規、もしくは放射光技術適用の有効性を評価する段階の課題。
 - 利用できる主な実験手法: XAFS、蛍光X線分析、イメージング、タンパク質結晶構造解析
 - 利用期間は最長1年。再申請によりさらに1年利用できることがある。
 - 利用報告書は公開。ただし、特許出願等がある場合、最長2年間の公開延期可能。
- ◆施設利用: 有償(通常ライン:27,300円／時、高性能ライン:53,550円／時。(単価改定を検討中))
成果非公開可
- ◆共同研究: 有償(研究費、共同研究員費:420,000円／年／人)。成果は公表

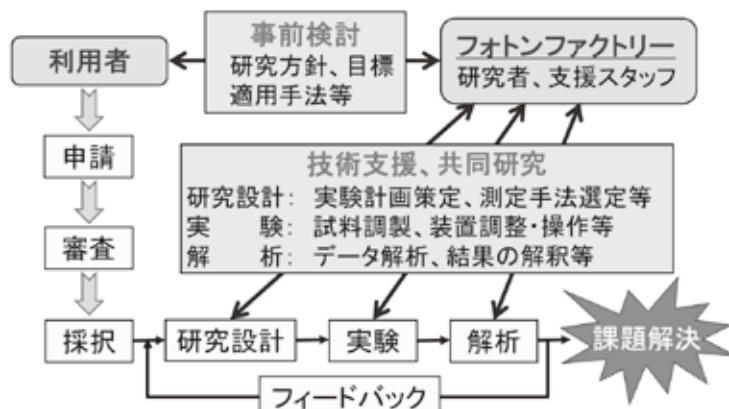
●技術支援

◆支援内容

- ・新規利用者でも利用しやすいように、課題申請の前段階からサポート。
- ・利用者の必要に応じ、研究設計から結果の解釈まで支援。
- ・利用期間は1年(3期)なので、いたん得た結果をフィードバックし、ターゲットや実験方法を絞り込んでいくことが可能。
- ・企業の事業活動には十分配慮。

◆支援要員

共用促進リエゾン、技術指導研究員



●セールスポイント

研究者、支援スタッフがPFの知恵と技術で支援
利用者の費用負担はない
利用有効期間1年(再申請で+1年可能)
年3回募集+随时受付(最短1ヶ月で利用開始)

不慣れな利用者でも取り付き易い
トライアルユースとして利用し易い
系統的な研究が可能
タイムリーな実験着手が可能